波動光学の風景 伝搬編

本宮佳典 著





はじめに

この電子書籍は、月刊 O plus E 誌の連載チュートリ アル記事「波動光学の風景」の、2006 年 12 月号から 2007 年 10 月号までに掲載されたものをまとめたもので ある。本編では、光の伝搬に付随する電磁場の状況な どについて、眺めてみる。

既巻で導いた単一周波数の平面波は理想化された概 念だが、実際的な光を構成する基本的な要素と見るこ とができる。古典力学において、やはり理想化された 概念である質点が、物質のモデルを構成する基本要素 になっているのと類似している。

例えば、伝搬方向がわずかずつ異なる平面波が多数 合成されたものとして、光ビームを理解することがで きる。また、周波数がわずかずつ異なる平面波が多数 合成されたものとして、光パルスを扱うことができる。 このように、平面波は、光の多様な在り方を理解する ための基本的な要素と見ることができる。

光の持つ重要な性質として,エネルギーを伝える作 用や,運動量を伝える作用がある。運動量を伝える作 用は,力を伝える作用と見ることもできる。光が伝える 力は大変弱いので,従来の光学では無視されることも 多かった。しかし近年では,光ピンセットなどで実際に 利用されており,今後も種々の活用が期待されている。 そもそもエネルギーと運動量は対になる概念であるか ら,両者は並列して眺める方が位置づけも内容も理解 しやすく,収まりもよいと思われる。

エネルギーも、運動量も、直接目で見ることのでき ない抽象的な概念である。質量を持たない光が、どこに どのように、エネルギーや運動量を保持し、伝えるの か、興味深いところである。これらを理解するために、 マクスウェル方程式とローレンツ力の式から、エネル ギーや運動量の密度、ポインティングベクトルやマクス ウェルの応力テンソルなどの概念を導く。また、これら を平面波の表式に適用することで、光に伴って力学的 な作用の伝搬する状況を眺めてみる。

一方,幾何光学では,光線の概念を用いて光の伝搬 を記述する。光線という,波動とは様相の異なる概念が, 波動光学の視点からどのように基礎づけられるのかを, アイコナールという概念を介して紹介する。

光が伝わるという最も基本的な現象も、その基礎と なる概念や現象をしっかり見ておくと、理解が深まって 行く。諸現象の理解にも役に立つし、さらに興味深い 光景も見えて来ると思う。読者にとって本書が、その ような興味を持って光の性質を見ていただくきっかけ になれば幸いである。

2013年3月 本宮 佳典

第17回	19.	光ビーム
第18回	20.	波束と群速度
第19回	21.	境界条件
第 20 回	22.	光のエネルギーと運動量
第 21 回	23.	光による力
第 22 回	24.	マクスウェルの応力テンソル
第 23 回	25.	導体で反射する s 偏光による力
第 24 回	26.	導体で反射するp 偏光による力
第 25 回	27.	媒質中の光と運動量
第26回	28.	幾何光学

第27回 29. アイコナール

次に式(19-16)の変形であるが,式(19-12)すなわち ガウシアンのフーリエ変換を与える式

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{x^2}{w_0^2}\right) \exp\left(-ik_x x\right) \mathrm{d}x$$
$$= \sqrt{\pi} w_0 \exp\left(-\frac{w_0^2}{4}k_x^2\right) \tag{19-27}$$

が、 w_0 を複素数a + biに拡張しても成立することを利用 した。両辺はそれぞれ、 w_0 が複素数であるとして見ても w_0 の関数として解析的である。したがって、解析接続し て w_0 を複素数に拡張したと考えれば、複素関数に慣れて いる人には違和感もないかもしれない。しかし、念のため 確認しておこう。式(19-27)が w_0 を複素数に拡張しても成 立することを確認できれば、その逆変換を適用することで 式(19-16)が導ける。

まず,式(19-27)に w_0 の代わりに複素数a + biを入れて左辺を変形すると,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{x^2}{(a+bi)^2}\right] \exp(-ik_x x) dx$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{x^2}{(a+bi)^2} - ik_x x\right] dx$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\left(\frac{x}{a+bi} + i\frac{a+bi}{2}k_x\right)^2 + \left(i\frac{a+bi}{2}k_x\right)^2\right] dx$$
$$= (a+bi) \exp\left[-\frac{(a+bi)^2}{4}k_x^2\right] \int_c \exp(-z^2) dz$$
(19-28)

となる。ここで、

$$z = \frac{x}{a+bi} + i\frac{a+bi}{2}k_x \tag{19-29}$$

として、xに関する積分を、複素数z平面における経路 C(図19-5)の積分に変形した。ただしaの符号は一 般性を失わずに正とした。

ここで、 $z = r \exp(i\phi)$ として、被積分関数 $\exp(-z^2)$ の絶対値を考えると、

$$|\exp(-z^{2})| = |\exp[-r^{2}(\cos 2\phi + i\sin 2\phi)]|$$

= exp(-r^{2}\cos 2\phi) (19-30)

となる。したがって $\cos 2\phi > 0$ となる領域,すなわち 図 19-5のハッチングされた領域では, $r \rightarrow \infty$ の極限 で 1/r よりもはやく0 に収束する。したがって,図 19



図19-5 z 平面上の積分経路 C, C'

-5のように積分路を Cから C'に変更したときに,C'の 実数軸上でない部分の積分は,その部分を遠方に移動 した極限で0となる。したがって,C'に沿った積分は, 実数軸上の $-\infty$ から ∞ の積分と同じ値になる。もちろ んこうなるためには,図 19-5における積分路 Cの傾 きが-45°から 45°の間に入っていなければならないが, そのためには $a^2 > b^2$ であればよい。式(19-16)の場合 についてみると, $a^2-b^2 = \operatorname{Re}[(a + bi)^2]$ は w_0^2 なので この条件は満足されている。したがって積分の値は式 (19-26)より $\sqrt{\pi}$ となり,式(19-28)は

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{x^2}{(a+bi)^2}\right] \exp(-ik_x x) dx$$
$$= (a+bi) \sqrt{\pi} \exp\left[-\frac{(a+bi)^2}{4}k_x^2\right]$$
(19-31)

となる。このことから式(19-16)の変形が導かれる。



Johann Carl Friedrich Gauss (Gauß)

1777年4月30日ドイツのBraunschweig生まれ,1855年2月23日 Göttingenに没す。歴史上もっとも 偉大な数学者の1人であり,物理学, 測地学,天文学,光学等に業績を残 した科学者でもある。幼少時から数 学の才を示し,言葉を話すようにな る前から計算をしていたと本人は述 べている。1807年にGöttingenの天 文台長に就任して終生務めた。ガウ スの名のつく定理や法則は数多いが,

光学ではガウス光学,ガウス型レンズなどに名を残している。最 愛の妻とは若くして死別,末の子供も間もなく亡くなり,再婚し た妻にも先立たれるなど,私生活はあまり恵まれなかった。 でなければならない。すなわち, $D_1 \ge D_2$ の法線方向 成分が等しい」という条件が必要であることが分かる。 同じことなので「Dの法線方向成分が連続」という表現 もできる。表面電荷のある場合については後述するが, 式(21-3)からDと表面電荷 ρ との関係を規定する条件 が導かれる。

最後に、式(21-4)を図 21-3の領域に適用すると、 磁東密度Bに関する境界条件が得られる。先の場合と同 様に積分領域の上下の面を境界面に近づける極限を考え る。このとき、やはり同様の議論が成り立ち、 $F_1 \ge B_2$ の法線方向成分が等しい」あるいは「Bの法線方向成分 が連続」という条件が必要であることが導かれる。

次章に説明するが,

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H} \tag{21-11}$$

として定義されるポインティングベクトルは,光のエネ ルギー流の密度を表す。一般性を失わずに境界面に垂直 に z 軸をとると,ポインティングベクトルの z 成分は

$$S_z = E_x H_y - E_y H_x \tag{21-12}$$

となる。右辺はEとHの境界面内方向の成分だけで決 まる量である。したがって、EとHの面内方向成分が 連続であるという境界条件から S_z が境界面で連続であ ることが分かる。これは、(表面電流がない場合に)光 のエネルギーが境界面で消費されることがないことを 示している。境界条件がそのための充分条件になって いることを意識しておきたい。

境界条件を、境界面の法線方向のベクトルnを使っ て表現することもあり、便利なこともある。例えば、 「 $H_1 \ge H_2$ の面内方向成分が等しい」という条件は、 「 $H_2 - H_1$ は面内方向成分を持たない」と言い換えること ができ、「 $H_2 - H_1$ はn と平行である」ということになる。 すなわち、

$$\boldsymbol{n} \times (\boldsymbol{H}_2 - \boldsymbol{H}_1) = 0 \tag{21-13}$$

と表せる。展開して移項すれば,

$$\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{H}_2 = \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{H}_1 \tag{21-14}$$

と書くこともできる。同様に、「 $E_1 \ge E_2$ の面内方向成 分が等しい」という条件は、

$$\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{E}_2 = \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{E}_1 \tag{21-15}$$

と書ける。また、「 $D_1 \ge D_2$ の法線方向成分が等しい」 という条件は式(21-10)で示した通り

$$\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{D}_2 = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{D}_1 \tag{21-16}$$

と書くことができる。同様に、「 B_1 と B_2 の法線方向成 分が等しい」という条件は

$$\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{B}_2 = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{B}_1 \tag{21-17}$$

と書ける。境界条件を式(21-14)~(21-17)の形で表す と、数式として扱う際に便利なことも多い。

さて,式(21-14)の条件を導く際に「電流密度*i*が有限であれば」という仮定をした。また,式(21-16)の条件を導く際に「電荷密度 *p*が有限であれば」という条件を用いた。系が誘電体だけで構成されていればこの条件は満たされる。また,導体であっても,高周波の電磁場に対する応答を考えるときのように,誘電率

$$\varepsilon^* = \varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega}$$

(18-6)

を持つ誘電体として扱う際にも,式(21-14),(21-16) を用いることができる。しかし,導体表面に真電荷や 真電流が存在する場合,式(21-1)の右辺の第2項は積 分領域を狭くしても0にならない。また,式(21-3)の 右辺も,積分領域を薄くしても0にならない。

表面電流がある場合の境界の様子を図21-4に示す。 この場合の磁場 H に関する境界条件を式(21-1)から導 くと,式(21-14)の代わりに





光がエネルギーを伴うことは、物体を暖めたり光電 池の起電力になるなどの身近な現象でも認識される。 光の反射率や透過率などという素朴な概念も、エネル ギー流としての定量的な意味が付随することで現実的 な意味やその重要性が理解される。

マクスウェル方程式が支配する電磁場の現象は,運動方程式が支配する力学現象とは別の世界の話のよう に見える。それにもかかわらず,電磁場にもエネルギ ーや運動量という概念が存在し,力学的なエネルギー や運動量との総和が保存するのは興味深いことである。 話の発端に戻って考えるなら,第9章でEやBを導入 する際に使ったローレンツ力の式

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{q}(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \tag{22-1}$$

に力学の概念である力 Fや速度 v が入っている。ここに 力学の概念と電磁気学の概念との接点がある。この式 を基礎において電磁場のエネルギーや運動量が定式化 されるため、力学系のエネルギーや運動量と整合する 普遍性の高い概念が構成される。この辺りをよく見て おくと、光の強度や力学作用にかかわる現象の意味を 理解しやすいであろう。

まず,式(22-1)から力学的な仕事に相当する量を導 く。電荷qの粒子が単位体積あたりN個あって,速度vで動いているとすると,電荷が電磁場から受ける単位 時間,単位体積あたりの仕事の大きさは

$$NF \cdot v = Nq(E + v \times B) \cdot v = NqE \cdot v = E \cdot i$$
 (22-2)

となる。そこで改めてマクスウェル方程式

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{H} = \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} + \boldsymbol{i} \tag{22-3}$$

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{22-4}$$

$$\operatorname{div} \boldsymbol{D} = \boldsymbol{\rho} \tag{22-5}$$

$$\operatorname{div} \boldsymbol{B} = 0 \tag{22-6}$$

を眺めてみよう。ここで,式(22-3)の両辺の E との内 積をとると,

$$\boldsymbol{E} \cdot \operatorname{rot} \boldsymbol{H} = \boldsymbol{E} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} + \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{i}$$
(22-7)

となり, *E*と*i*の内積が現れる。同様に式(22-4)の両辺の*H*との内積をとって

$$\boldsymbol{H} \cdot \operatorname{rot} \boldsymbol{E} = -\boldsymbol{H} \cdot \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$
(22-8)

という式を導いておく。これは、マクスウェル方程式 を眺めると、式(22-3)から式(22-7)を導いたのと対に なっていて対称性がよく、ベクトル解析の一般的な関 係式

$$\operatorname{div}(\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{H}) = \boldsymbol{H} \cdot \operatorname{rot} \boldsymbol{E} - \boldsymbol{E} \cdot \operatorname{rot} \boldsymbol{H}$$
(22-9)

を使える形になる。式(22-9)は、左辺を成分表示して div, rotを適用していくと、



光の持つ運動量や光の力学的な作用は,従来は光学 というより電磁気学か電気力学の範疇で扱われる現象 だったように思う。しかし,光による力を利用する光 ピンセットなどの技術が普及し,光学技術者にもなじ み深い現象,あるいは当事者としてかかわる現象にな ってきている。

前章では、単位体積あたりに働くローレンツ力の式

$$\boldsymbol{f} = \boldsymbol{\rho}_{\mathrm{e}}\boldsymbol{E} + \boldsymbol{i}_{\mathrm{e}} \times \boldsymbol{B} \tag{23-1}$$

と,マクスウェル方程式

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{H} = \frac{\partial \boldsymbol{D}}{\partial t} + \boldsymbol{i}_{e} \tag{23-2}$$

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{23-3}$$

 $\operatorname{div} \boldsymbol{D} = \boldsymbol{\rho}_{\mathrm{e}} \tag{23-4}$

$$\operatorname{div} \boldsymbol{B} = 0 \tag{23-5}$$

から、真電荷密度 $\rho_{\rm e}$ と真電流(伝導電流)密度 $i_{\rm e}$ に及 ぼされる力

$$\boldsymbol{f} = \operatorname{div} \boldsymbol{T} + \frac{1}{2} \left| \boldsymbol{E} \right|^{2} \operatorname{grad} \boldsymbol{\varepsilon} + \frac{1}{2} \left| \boldsymbol{H} \right|^{2} \operatorname{grad} \boldsymbol{\mu} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{S} \right)$$
(23-6)

を導いた(前章では ρ やiに添え字をつけなかったが, ここではeを付した)。

本章では、分極電荷に働く力も含めて、物質に働く 力を考える。そのために、真空中のマクスウェル方程 式を用いる。真空中のマクスウェル方程式を物質中に 適用する場合は,電荷密度や電流密度として,物質の 分極や磁化に由来する成分も含める。真空中のマクス ウェル方程式は

$$\frac{1}{\mu_{0}} \operatorname{rot} \boldsymbol{B} = \boldsymbol{\varepsilon}_{0} \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} + \boldsymbol{i}$$
$$= \boldsymbol{\varepsilon}_{0} \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} + \boldsymbol{i}_{e} + \boldsymbol{i}_{d} + \boldsymbol{i}_{m}$$
$$= \boldsymbol{\varepsilon}_{0} \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} + \boldsymbol{i}_{e} + \frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t} + \operatorname{rot} \boldsymbol{M}$$
(23-7)

$$\operatorname{rot} \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{23-8}$$

 $\varepsilon_0 \operatorname{div} \boldsymbol{E} = \boldsymbol{\rho}$

$$= \rho_{\rm e} + \rho_{\rm d}$$
$$= \rho_{\rm e} - \operatorname{div} \boldsymbol{P}$$
(23-9)

$$\operatorname{div} \boldsymbol{B} = 0 \tag{23-10}$$

である。電荷密度と電流密度の内訳を $\rho = \rho_e + \rho_d$, $i = i_e + i_d + i_m$ として示した。添え字 e は真電荷や真電流に 由来するもの,d は分極電荷に由来するもの,m は磁化 に由来するものをそれぞれ表す。真電荷や真電流だけ でなく,分極電荷や磁化電流も含めたすべての電荷密 度 ρ ,電流密度iに働くローレンツ力をf'と表すと,

$$f' = (\rho_{e} + \rho_{d}) E + (i_{e} + i_{d} + i_{m}) \times B$$
$$= \rho E + i \times B$$
$$= \varepsilon_{0} E \operatorname{div} E + \left(\frac{1}{\mu_{0}} \operatorname{rot} B - \varepsilon_{0} \frac{\partial E}{\partial t}\right) \times B$$

$$\rho_{\rm s} = -\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{D} = -\varepsilon_0 \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{E}(x, y, -0, t)$$

$$= -\varepsilon_0 \begin{pmatrix} 0\\0\\1 \end{pmatrix} \cdot 2E_0 \begin{pmatrix} 0\\0\\\sin\theta \end{pmatrix} \exp(ikx\sin\theta - i\omega t)$$

$$= -2\varepsilon_0 E_0 \sin\theta \exp(ikx\sin\theta - i\omega t) \qquad (26-17)$$

となることが分かる。また、導体表面の電流は、境界 条件の式(21-18)を用いると、

$$\begin{aligned} \boldsymbol{j}_{s} &= -\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{H} = - \begin{pmatrix} 0\\0\\1 \end{pmatrix} \times \boldsymbol{H}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, -0, t) \\ &= \begin{pmatrix} 0\\0\\1 \end{pmatrix} \times 2E_{0} \sqrt{\frac{\varepsilon_{0}}{\mu_{0}}} \begin{pmatrix} 0\\1\\0 \end{pmatrix} \exp(ikx\sin\theta - i\omega t) \\ &= -2E_{0} \sqrt{\frac{\varepsilon_{0}}{\mu_{0}}} \begin{pmatrix} 1\\0\\0 \end{pmatrix} \exp(ikx\sin\theta - i\omega t) \quad (26-18) \end{aligned}$$

となることが分かる。ここで $\partial \rho / \partial t$ + div \mathbf{j}_s を計算して 式(26-9)を使うと,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho_{\rm s}}{\partial t} + {\rm div} \boldsymbol{j}_{\rm s} &= \frac{\partial \rho_{\rm s}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (\boldsymbol{j}_{\rm s})_x + \frac{\partial}{\partial y} (\boldsymbol{j}_{\rm s})_y \\ &= 2i\varepsilon_0 E_0 \omega {\rm sin} \theta \exp(ikx {\rm sin} \theta - i\omega t) \\ &- 2iE_0 \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} k {\rm sin} \theta \exp(ikx {\rm sin} \theta - i\omega t) = 0 \end{aligned}$$

$$(26-19)$$

となり,表面電荷の保存則が満足されていることが確認できる。

導体で光が反射している状況が把握できてきたので、 次に導体が受ける力について考えてみよう。導体と入 射光、反射光のある状況を図26-2に示す。図の面 Σ は、導体表面を含む薄い領域を囲む閉曲面であるとす る。この面内の領域に働く力は、再掲式(23-21)により、

$$F = \iint_{\Sigma} T' n \, \mathrm{d}s - \frac{\partial}{\partial t} \iiint_{v} \varepsilon_{0} \mu \left(E \times H \right) \mathrm{d}v \quad$$
再掲(23-21)
となる。

ここで、第2項の積分は、 $E \times H$ が面 Σ の近傍でx軸 の方向を向いているため、面に働く力への寄与はない。 あるいは第2項は場の量の時間微分であるから、周期的 な振動場について計算しても時間平均をとれば値は0に なる。

したがって,面に働く力Fへの寄与は第1項のみである。第1項の積分の被積分関数に応力テンソルT'の式 (23–18)を使う。すなわち,





$$T' \cdot \mathbf{n} = \varepsilon_{0} \begin{pmatrix} E_{x}^{2} - \frac{1}{2} |\mathbf{E}|^{2} & E_{x}E_{y} & E_{x}E_{z} \\ E_{y}E_{x} & E_{y}^{2} - \frac{1}{2} |\mathbf{E}|^{2} & E_{y}E_{z} \\ E_{z}E_{x} & E_{z}E_{y} & E_{z}^{2} - \frac{1}{2} |\mathbf{E}|^{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ + \mu_{0} \begin{pmatrix} H_{x}^{2} - \frac{1}{2} |\mathbf{H}|^{2} & H_{x}H_{y} & H_{x}H_{z} \\ H_{y}H_{x} & H_{y}^{2} - \frac{1}{2} |\mathbf{H}|^{2} & H_{y}H_{z} \\ H_{z}H_{x} & H_{z}H_{y} & H_{z}^{2} - \frac{1}{2} |\mathbf{H}|^{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ (26-20)$$

に対して,式(26-15),(26-16)でz→0としたもの を代入すると,

1

$$\boldsymbol{T}' \cdot \boldsymbol{n} = \begin{vmatrix} -\frac{\varepsilon_0}{2} E_z^2 - \frac{\mu_0}{2} H_y^2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\varepsilon_0}{2} E_z^2 + \frac{\mu_0}{2} H_y^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\varepsilon_0}{2} E_z^2 - \frac{\mu_0}{2} H_y^2 \end{vmatrix}$$
$$\times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 2\varepsilon_0 E_0^2 \cos^2\theta \cos^2(kx \sin\theta - \omega t) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
(26-21)

となる。すなわち前章の場合と同じ大きさの圧力を受



幾何光学において光線の伝搬を記述する基本的な法 則として光線方程式

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \left(n \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} \right) = \operatorname{grad} n \tag{29-1}$$

があることを前章で紹介した。波動光学に基づいてこ の式を導くことを考える。

真空中のマクスウェル方程式において、時間発展が 位相因子 $exp(-i\omega t)$ で記述される解を考えると、電場の x, y, z成分も磁場のx, y, z成分も同じ波動方程式

$$\nabla^2 \phi + k_0^2 \phi = 0 \quad \left(\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} \right) \quad (29-2)$$

を満たすことが導かれる (∇^2 はラプラス演算子)。ここ で, k_0 は

$$k_0 = \omega \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \tag{29-3}$$

で定義される。光速度 c_0 や波長 λ_0 との関係は,式(29 -2)の平面波解を求めると分かるように,

$$k_0 = \frac{\omega}{c_0} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \tag{29-4}$$

となる。

次に物質中の場合を考える。真電荷も真電流もなく、 $B = \mu_0 H$ が成り立つ媒質を考え、 ϵ_0 を物質の誘電率 ϵ に置き換える。すなわち、式(29-2)中の k_0 を

$$k = \omega \sqrt{\varepsilon \mu_0} = \frac{n\omega}{c_0} = \frac{2\pi}{\lambda}$$
(29-5)

が得られる(補足1参照)。 ここで,式(29-6)の解であって,

$$\phi(x,y,z) = A(x,y,z) \exp[ik_0 S(x,y,z)]$$
(29-7)

という形のものを考える。関数A(x, y, z)は振幅であり, 指数部にある $k_0S(x, y, z)$ が場の位相に相当する。関数 Sは実関数であるとする。

関数*S*(*x*, *y*, *z*)のイメージや特徴を把握するために, 比較的簡単な場の例として,屈折率*n*の媒質中を単位 ベクトル*n*=(*n_x*, *n_y*, *n_z*)の方向に進む平面波

$$\phi(x,y,z) = A \exp[ik(n_x x + n_y y + n_z z)]$$
$$= A \exp[ink_0(n_x x + n_y y + n_z z)]$$
(29-8)

を考えてみよう。この場合の関数S(x, y, z)は,

$$S(x,y,z) = n(n_x x + n_y y + n_z z)$$
(29-9)

となる。図29-1に示すようにnに垂直な等高面(S(x, y, z)の値が一定となる面)を持つ。光線の方向に単位 距離移動すると値が屈折率の値nだけ増加する。すな わち,関数S(x, y, z)の勾配($\partial S/\partial x \, \alpha E$)は屈折率の オーダーの量である。勾配は無次元量なので,長さの 単位にnmを使ってもmを使ってもSの傾きの値は変 わらない。平面波の場合の勾配は空間の到る場所で一 定だが,一般の場でも勾配の大きさは屈折率のオーダ 彩 5

■ 事項

アイコナール56右11直進51左4アイコナール方程式56右11定在波44左4位相速度7右12電気力線23右下3周果律10右6電磁場の運動量20左下13s 幅次30右2電磁場の運動量33左下4エネルギー17左11電磁場のエネルギー密度17右下3応力テンソル19下2電磁場のエネルギー密度17右下5応力テンソル22右4電場のエネルギー密度17右下5応力テンソル25左2等アイコナール面56右11応力テンソル22右1波頭速度9右11応力テンソル32右1波頭速度9右15ボカテンソル32右1水の光7左12広力テンソル32右1波頭速度9右15ボカテンソル38左下2パルス先7左12広力テンソル36左5反射の法則51右15ガウンマル3右下3擬送波9左5ガウン3右下3擬近4415ガウン4ケ7左555ガウス積5右14p四55ガウス積5右14p555ガウス積5左下9表面電 </th <th></th> <th>頁</th> <th>カラム</th> <th>行</th> <th></th> <th>頁</th> <th>カラム</th> <th>行</th>		頁	カラム	行		頁	カラム	行
アイコナール方程式56右11定在波44 L 4位相速度7右12電気力線23右下3因果律10右6電磁場の運動量20 L 下13s 幅光30右2電磁場の運動量33 L 下4エネルギー17 L 11電磁場のエネルギー密度17 L T 応力テンソル19下2電磁場のエネルギー密度17 L T T T 応力テンソル22 L 4電場のエネルギー密度17 L T T 応力テンソル22 L 4電場のエネルギー密度17 L T T 応力テンソル22 L 4電場のエネルギー密度17 L T T 応力テンソル22 L 1波頭速度9 L T T 応力テンソル32 L 1波風速速9 L T 応力テンソル32 L 1波風速速9 L T 応力テンソル32 L 1<	アイコナール	56	右	11	直進	51	左	4
位相速度7右12電気力線23右下 3因果律10右6電磁場の運動量20左下 13s 偏光30右2電磁場の運動量33左下 4エネルギー17左11電磁場のエネルギー密度17右下 3応力テンソル19下 2電磁場のエネルギー密度17右下 5応力テンソル22右4電場のエネルギー密度17右下 5応力テンソル25左2等アイコナール面56右13応力テンソル32右1波頭速度9右11応力テンソル32右1波頭速度9右15応力テンソル38左下 2パルス光7左12応力テンソル38左下 3 </td <td>アイコナール方程式</td> <td>56</td> <td>右</td> <td>11</td> <td>定在波</td> <td>44</td> <td>左</td> <td>4</td>	アイコナール方程式	56	右	11	定在波	44	左	4
因果律10右6電磁場の運動量20左下13s 偏光30右2電磁場の運動量33左下4エネルギー17左11電磁場のエネルギー密度17右下3応力テンソル19下2電磁場のエネルギー密度17右下5応力テンソル22右4電場のエネルギー密度17右下5応力テンソル22右41電頻のエネルギー密度17右下5応力テンソル25左2等アイコナール面56右13応力テンソル32右1波頭速度9右11応力テンソル38左下2パルス洗7左12応力テンソル38左下2パルス洗7左12応力テンソル46左5反射の法則51右15ガウシアンビーム3右下3搬送搬送9左5ガウス積分5右14pp<	位相速度	7	右	12	電気力線	23	右	下 3
s 福光30右2電磁場の運動量33左下4エネルギー17左11電磁場のエネルギー密度17右下3応力テンソル19下2電磁場のエネルギー密度17右下5応力テンソル22右4電場のエネルギー密度17右下5応力テンソル25左2等アイコナール面56右13応力テンソル32右1波頭速度9右11応力テンソル38左下2パルス光7左12応力テンソル46左5反射の法則51右15ガウシアンビーム3右下3搬送波9左5ガウス積分5右14p偏光36左8幾何光学50左2光ビーム1右3境界条件12左12微分形のマクスウェル方程式12右8曲率半径5左下9表面電荷15左6屈折の法則51右17表面電荷14右73光線方程式50左下2表面電流34右3最短次路長の原理51右下13フェルマーの原理51右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ボインティングベクトル14左15スカラー5ボ目0ボインティングベクトル14右827ス線方55「右10ボインティングベクトル14	因果律	10	右	6	電磁場の運動量	20	左	下 13
xネルギー17左11電磁場のエネルギー密度17右下 3応力テンソル19下 2電磁場のエネルギー密度44右5応力テンソル22右4電場のエネルギー密度17右下 5応力テンソル25左2等アイコナール面56右13応力テンソル32右1波頭速度9右11応力テンソル32右1波頭速度9右12応力テンソル38左下 2パルス光7左12応力テンソル46左5反射の法則51右15ガウシアンビーム3右下 3搬送波9左5ガウス積分5右14p 偏光36左8幾何光学50左2光ビーム1右3境界条件12左12微分形のマクスウェル方程式12右8曲率半径5左下 9表面電荷15左6屈折の法則51右17表面電流14右7光線方程式50左下 2表面電流34右3最短光路長の原理51右下 13フェルマーの原理51右6ジュール熱17右下 9幅射のエネルギー密度42右6進行波43右5ボインティングベクトル14左15スカラー場近似2左下 10ボインティングベクトル14右8スカラー場近2左下 10ボインティングベクトル14右	s 偏光	30	右	2	電磁場の運動量	33	左	下4
応力テンソル19下2電磁場のエネルギー密度44右5応力テンソル22右4電場のエネルギー密度17右下5応力テンソル25左2等アイコナール面56右13応力テンソル32右1波頭速度9右11広力テンソル38左下2パルス光7左12応力テンソル46左5反射の法則51右15ガウシアンビーム3右下3搬送波9左5ガウス積分5右14p偏光36左8幾何光学50左2光ビーム1右3境界条件12左12微分形のマクスウェル方程式12右8曲率半径5左下9表面電荷15左6屈折の法則51右F13フェルマーの原理51右71凝壊方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右F13フェルマーの原理51右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6<	エネルギー	17	左	11	電磁場のエネルギー密度	17	右	下 3
応力テンソル22右4電場のエネルギー密度17右下5応力テンソル25左2等アイコナール面56右13応力テンソル32右1波頭速度9右11応力テンソル38左下2パルス光7左12応力テンソル46左5反射の法則51右15ガウシアンビーム3右下3搬送波9左5ガウス積分5右14p偏光36左8幾何光学50左2光ビーム1右3境界条件12左12微分形のマクスウェル方程式12右8曲率半径5左下9表面電荷15左6屈折の法則51右17表面電流14右下3光線方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右6道石5ボ<	応力テンソル	19		下 2	電磁場のエネルギー密度	44	右	5
応力テンソル25左2等アイコナール面56右13応力テンソル32右1波頭速度9右11応力テンソル38左下2パレス光7左12応力テンソル46左5反射の法則51右15ガウシアンビーム3右下3搬送波9左5ガウス積分5右14p偏光36左8幾何光学50左2光ビーム1右3境界条件12左12微分形のマクスウェル方程式12右8曲率半径5左下9表面電荷15左6屈折の法則51右17表面電流14右下3光線方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右下14磁場のエネルギー密度17右下9輻射の圧力42右6近っル熱17右下9輻射の圧力42右6進行波43右5ポインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ボインティングベクトル17左下10スカラー場近似2左19包絡線8左下7スネルの法則3左8二下7スネルの法則51右6ローレンツ力16左12スカウ51右6ローレンツ力16左12スカラ51右 </td <td>応力テンソル</td> <td>22</td> <td>右</td> <td>4</td> <td>電場のエネルギー密度</td> <td>17</td> <td>右</td> <td>下 5</td>	応力テンソル	22	右	4	電場のエネルギー密度	17	右	下 5
応力テンソル32右1波頭速度9右11応力テンソル38左下2パルス光7左12応力テンソル46左5反射の法則51右15ガウシアンビーム3右下3搬送波9左5ガウス積分5右14 p 偏光36左8幾何光学50左2光ビーム1右3境界条件12左12微分形のマクスウェル方程式12右8曲率半径5左下9表面電荷15左6屈折の法則51右17表面電荷34右73光線方程式50左下2表面電流34右33最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右下14磁場のエネルギー密度17右下5輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ボインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ボインティングベクトル17左下10スカラー場近似2左下10ボインティングベクトル44右8スカラー場の方程式2左19包給線8左下7スネルの法則3左8ローレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツ力16左12	応力テンソル	25	左	2	等アイコナール面	56	右	13
応力テンソル38左下2パルス光7左12応力テンソル46左5反射の法則51右15ガウシアンビーム3右下3搬送波9左5ガウス積分5右14 p 偏光36左8幾何光学50左2光ビーム1右3境界条件12左12微分形のマクスウェル方程式12右8曲率半径5左下9表面電荷15左6屈折の法則51右17表面電荷37右下5群速度8左下5表面電流14右下3光線方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右下14磁場のエネルギー密度17右下9輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ボインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ボインティングベクトル14右8スカラー場近42左19包給線8左下7スネルの法則3左8四ーレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツ力21左7	応力テンソル	32	右	1	波頭速度	9	右	11
応力テンソル46左5反射の法則51右15ガウシアンビーム3右下3搬送波9左5ガウス積分5右14 p 偏光36左8幾何光学50左2光ビーム1右3境界条件12左12微分形のマクスウェル方程式12右8曲率半径5左下9表面電荷15左6屈折の法則51右17表面電荷37右下5群速度8左下5表面電流14右下3光線方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ボインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ボインティングベクトル14右8スカラー場近似2左下10ボインティングベクトル44右8スカラー場の方程式2左下10ボインティングベクトル44右8スカラー場の方程式2左19包給線8左下7スネルの法則3左8ローレンツカ16左12スネルの法則51右6ローレンツカ21左7	応力テンソル	38	左	下 2	パルス光	7	左	12
ガウシアンビーム3右下 3搬送波9左5ガウス積分5右14 p 偏光36左8幾何光学50左2光ビーム1右3境界条件12左12微分形のマクスウェル方程式12右8曲率半径5左下9表面電荷15左6屈折の法則51右17表面電荷37右下5群速度8左下5表面電流14右下3光線方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右6ジュール熱17右下9輻射の圧力42右6進行波43右5ボインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ボインティングベクトル14右8スカラー場の方程式2左下10ボインティングベクトル44右8スカラー場の方程式2左19包給線8左17スネルの法則3左8ローレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツ力16左12	応力テンソル	46	左	5	反射の法則	51	右	15
ガウス積分5右14p 偏光36左8幾何光学50左2光ビーム1右3境界条件12左12微分形のマクスウェル方程式12右8曲率半径5左下9表面電荷15左6屈折の法則51右17表面電流37右下5群速度8左下5表面電流14右下3光線方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右6ジュール熱17右下9輻射の圧力42右6進行波43右5ポインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ポインティングベクトル14右8スカラー場の方程式2左下10ポインティングベクトル44右8スホルの法則3左8た下721左7	ガウシアンビーム	3	右	下 3	搬送波	9	左	5
幾何光学50左2光ビーム1右3境界条件12左12左12右8曲率半径5左下9表面電荷15左6屈折の法則51右17表面電荷37右下5群速度8左下5表面電流14右下3光線方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右下14磁場のエネルギー密度17右下5輻射の圧力42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ポインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ポインティングベクトル14右8スカラー場近似2左下10ポインティングベクトル44右8スカラー場の方程式2左下10ポインティングベクトル44右8スカッー場の方程式2左19包絡線8左下7スネルの法則51右6ローレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツカ21左7	ガウス積分	5	右	14	p 偏光	36	左	8
境界条件12左12荷8曲率半径5左下9表面電荷15左6屈折の法則51右17表面電荷37右下5群速度8左下5表面電流14右下3光線方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右下14磁場のエネルギー密度17右下5輻射の圧力42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ポインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ポインティングベクトル14右8スカラー場の方程式2左下10ポインティングベクトル44右8スネルの法則3左8左下7スネルの法則51右6ローレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツカ21左7	幾何光学	50	左	2	光ビーム	1	右	3
曲率半径5左下9表面電荷15左6屈折の法則51右17表面電荷37右下5群速度8左下5表面電流14右下3光線方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右下14磁場のエネルギー密度17右下5輻射の圧力42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ポインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ポインティングベクトル17左下10スカラー場の方程式2左19包絡線8左下7スネルの法則3左8二121212スネルの法則51右6ローレンツ力21左7	境界条件	12	左	12	微分形のマクスウェル方程式	12	右	8
屈折の法則51右17表面電荷37右下5群速度8左下5表面電流14右下3光線方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右下14磁場のエネルギー密度17右下5輻射の圧力42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ボインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ポインティングベクトル14右8スカラー場の方程式2左下10ポインティングベクトル44右8スネルの法則3左8左下7スネルの法則51右6ローレンツ力21左7	曲率半径	5	左	下 9	表面電荷	15	左	6
群速度8左下5表面電流14右下3光線方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右下14磁場のエネルギー密度17右下5輻射の圧力42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ポインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ポインティングベクトル17左下10スカラー場の方程式2左19包絡線8左下7スネルの法則51右6ローレンツ力16左12	屈折の法則	51	右	17	表面電荷	37	右	下 5
光線方程式50左下2表面電流34右3最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右下14磁場のエネルギー密度17右下5輻射の圧力42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ポインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ポインティングベクトル17左下10スカラー場の方程式2左19包絡線8左下7スネルの法則51右6ローレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツ力21左7	群速度	8	左	下 5	表面電流	14	右	下 3
最短光路長の原理51右下13フェルマーの原理51右下14磁場のエネルギー密度17右下5輻射の圧力42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ポインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ポインティングベクトル17左下10スカラー場の方程式2左19包絡線8左下7スネルの法則51右6ローレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツ力21左7	光線方程式	50	左	下 2	表面電流	34	右	3
磁場のエネルギー密度17右下5輻射の圧力42右6ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ポインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ポインティングベクトル17左下10スカラー場近似2左下10ポインティングベクトル44右8スカラー場の方程式2左19包絡線8左下7スネルの法則3左8ローレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツ力21左7	最短光路長の原理	51	右	下 13	フェルマーの原理	51	右	下 14
ジュール熱17右下9輻射のエネルギー密度42右6進行波43右5ポインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ポインティングベクトル17左下10スカラー場近似2左下10ポインティングベクトル44右8スカラー場の方程式2左19包絡線8左下7スネルの法則3左8ローレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツ力21左7	磁場のエネルギー密度	17	右	下 5	輻射の圧力	42	右	6
進行波43右5ポインティングベクトル14左15スカラー波近似2左下10ポインティングベクトル17左下10スカラー場近似2左下10ポインティングベクトル44右8スカラー場の方程式2左19包絡線8左下7スネルの法則3左8ローレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツ力21左7	ジュール熱	17	右	下 9	輻射のエネルギー密度	42	右	6
スカラー波近似2左下10ポインティングベクトル17左下10スカラー場近似2左下10ポインティングベクトル44右8スカラー場の方程式2左19包絡線8左下7スネルの法則3左8ローレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツ力21左7	進行波	43	右	5	ポインティングベクトル	14	左	15
スカラー場近似2左下10ポインティングベクトル44右8スカラー場の方程式2左19包絡線8左下7スネルの法則3左8ローレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツ力21左7	スカラー波近似	2	左	下 10	ポインティングベクトル	17	左	下 10
スカラー場の方程式2左19包絡線8左下7スネルの法則3左8ローレンツ力16左12スネルの法則51右6ローレンツ力21左7	スカラー場近似	2	左	下 10	ポインティングベクトル	44	右	8
スネルの法則3 左 8ローレンツ力16 左 12スネルの法則51 右 6ローレンツ力21 左 7	スカラー場の方程式	2	左	19	包絡線	8	左	下7
スネルの法則 51 右 6 ローレンツ力 21 左 7	スネルの法則	3	左	8	ローレンツ力	16	左	12
	スネルの法則	51	右	6	ローレンツ力	21	左	7
積分形のマクスウェル方程式 12 左 17 ローレンツ力 34 右 1	積分形のマクスウェル方程式	12	左	17	ローレンツ力	34	右	1

索 弓

■人名

	頁	カラム	行
Ampère	15	人物	1
Arago	11	人物	10
Bernoulli, Jacob	15	人物	11
Biot	15	人物	19
Biot	35	人物	1
Cauchy	15	人物	18
Clairaut	59	人物	14
Colburn	59	人物	9
d'Alembert	15	人物	11
Davy	24	人物	12
Diophantus	54	人物	14
Euler	15	人物	11
Faraday	24	人物	1
Fermat	54	人物	1
Fizeau	11	人物	1
Foucault	11	人物	13
Fresnel	15	人物	19
Gauss	6	人物	1
Hamilton	59	人物	1
Heaviside	20	人物	13
Heron	54	左	下 2
Lagrange	15	人物	12
Laplace	15	人物	19
Laplace	35	人物	12
Laplace	59	人物	15
Monge	35	人物	7
Newton	59	人物	14
Ørsted	15	人物	20
Ørsted	42	人物	1
Poynting	20	人物	1

	頁	カラム	行
Ritter	42	人物	12
Robertson	20	人物	16
Romagnosi	42	人物	19
Savart	35	人物	18
Wiles	54	人物	下1

著者略歴 本宮佳典(ほんぐう・よしのり), Yoshinori Hongu

1956年 神奈川県藤沢市生まれ 1975年 神奈川県立湘南高等学校卒業 1979年 東京大学理学部物理学科卒業 1984年 東京大学大学院理学系研究科物理学専攻博士課程修了 理学博士 同年,株式会社東芝入社 光応用機器の研究開発に従事 2012年 東芝リサーチ・コンサルティング株式会社 シニアフェロー 2018年 株式会社東芝 研究開発センター (2021.10退職) 法政大学理工学部 (兼任講師) (2018.4~)

第20回(2019年度)応用物理学会業績賞(教育業績)受賞



「波動光学の風景」の情報は以下のURLで公開しています。https://www.adcom-media.co.jp/opluse/wave/

波動光学の風景 伝搬編

	2013年	3月26日初版発行
	2023年2	2月1日第2版発行
著 者	本 宮 佳 典	
発行者	喜 多 野乃子	
発行所	アドコム・メディア株式会社	
	〒169-0073 東京都新宿区	百人町2-21-27
	電話 (03)33	367-0571(代)

Advanced Communication Media Co. Ltd., Tokyo, Japan, 2013 ISBN 978-4-910636-11-5 C3042 ¥4000E © Yoshinori Hongu 2013 印刷/製本 (㈱プックフロント Printed in Japan

・本書に掲載する著作物の複製権・翻訳権・上映権・譲渡権・公衆送信権
 (送信可能化権を含む)はアドコム・メディア㈱が保有します。

・ **JCOPY** <出版者著作権管理機構 委託出版物>

本書の無断複製は著作権法上での例外を除き禁じられています。複製される場合は、そのつど事前に、

出版者著作権管理機構(電話 03-5244-5088, FAX 03-5244-5089, E-mail info@jcopy.or.jp)の 許諾を得てください。